06;07 Модификация приповерхностных слоев фоточувствительных стекол при электронно-лучевой обработке

© Н.В. Никоноров, А.И. Сидоров, В.А. Цехомский, А.В. Нащекин, О.А. Усов, О.А. Подсвиров, С.В. Поплёвкин

Санкт-Петербургский государственный университет информационных технологий, механики и оптики Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербург Санкт-Петербургский государственный политехнический университет

Поступило в Редакцию 31 июля 2008 г.

Электронно-лучевая обработка фоточувствительных силикатных стекол, содержащих ионы серебра или меди, приводит к формированию в приповерхностном слое металлических наночастиц. Характеристики этого слоя зависят от типа ионов металла, предварительной и последующей термообработки, а также от распределения заряда и условий стока электронов по поверхности. Пространственный профиль распределения заряда может приводить к формированию линзоподобных структур толщиной 200-400 nm.

PACS: 81.16.Rf

Двумерные плазмонные структуры находят применение в интегральной оптике в качестве плазмонных волноводов, микрорезонаторов и других пассивных элементов [1]. Как правило, они формируются на поверхности подложки ионно-лучевым методом либо с помощью фотолитографии, либо ионным обменом (например, [2]). Фоточувствительные гетерогенные стекла (ФЧГС), например, фотохромные [3], мультихромные [4] и фототерморефрактивные стекла [5] представляют интерес для формирования плазмонных структур, так как они исходно содержат ионы металлов (Ag⁺, Cu⁺). Обработка ФЧГС ультрафиолетовым излучением в сочетании с термообработкой позволяет выделить в объеме стекла металлическую фазу в виде нанокластеров различного размера и формы (Ag^o_n, Cu^o_n), а также вырастить на этих центрах нуклеации диэлектрические кристаллы в виде галогенидов серебра (AgBr) или меди (CuCl). Достоинством электронно-лучевой обработки

35

является возможность создания металлических нанокластеров в тонком приповерхностном слое. В настоящей работе рассмотрена возможность использования электронно-лучевой и термической обработки для создания металлических нанокластеров в тонком приповерхностном слое ФЧГС.

В работе исследовались следующие образцы фоточувствительных стекол ФЧГС:

№ 1. Силикатное стекло 15Na₂O-5ZnO-4Al₂O₃-70SiO₂-5NaF-1KBr-0.01Ag₂O-0.01CeO₂ (mol.%). Образец исходно представлял собой бесцветное и прозрачное стекло.

№ 2. Силикатное стекло аналогичного состава, что и для образца № 1, но прошедшее предварительную термическую обработку при $T = 540^{\circ}$ С в течение 2 h. В результате обработки стекло приобрело слабую сиреневую окраску, связанную с формированием нанокристаллов AgBr, а также с образованием незначительного количества наночастиц металлического серебра [3].

№ 3. Фотохромное стекло марки ФХС-7 [6], содержащее нанокристаллы CuCl. Образец исходно представлял собой прозрачное стекло со слабовыраженной желто-зеленой окраской.

Облучение образцов ФЧГС электронами проводилось при комнатной температуре на сканирующем электронном микроскопе CamScan Series 4 DV100 при энергии электронов 20 keV и токе 2 nA. Доза облучения составляла 11.4 mC/cm². Размер облучаемой зоны был равен $270 \times 350 \,\mu$ m. Для обеспечения стока заряда облучаемая зона окружалась кольцевым электродом, расположенным на расстоянии $200-300 \,\mu$ m. После облучения проводилась термическая обработка образцов при $T = 540^{\circ}$ C в течение 2 h.

Электронно-лучевое воздействие на образец № 1 не привело к появлению видимых изменений поверхности. Однако при последующей термической обработке образца произошло потемнение облученной зоны и появление на ней трех интерференционных колец (рис. 1, *a*). Изображения получены с помощью оптического микроскопа Nikon Eclipse LV150. По мере удаления от центра облученной зоны ширина интерференционных колец и расстояние между ними уменьшаются. Наблюдается также широкая интерференционная полоса, окружающая облученную зону по внешнему периметру.

Воздействие электронного луча на образец № 2 сразу привело к потемнению поверхности. Последующая термическая оработка привела



Рис. 1. Изображения поверхности образцов после облучения электронами и термической обработки: $a - N_{\rm e}$ 1, $b - N_{\rm e}$ 2, $c - N_{\rm e}$ 3. Масштаб — 300 μ m.

к увеличению оптического поглощения в облученной зоне (рис. 1, b). Интерференционные кольца на данном образце не наблюдаются, однако на краях облученной зоны потемнение более сильно, чем в центре. При облучении электронами образца № 3 также произошло увеличение поглощения в приповерхностном слое облученной зоны. Кроме того, в данном случае возникли ярко выраженные дендритоподобные ветви, образовавшиеся в результате металлизации поверхности при стоке электронов и направленные с краев облученной зоны к кольцевому электроду (рис. 1, c). Последующая термическая обработка увеличила коэффициент поглощения в облученной зоне. Потемнение облученной зоны в данном случае равномерно, а интерференционные кольца отсутствуют.

В образце № 1 под действием электронного луча в приповерхностном слое формируются нейтральные атомы Ag°. Расчет показывает, что торможение электронов при начальной энергии 20 keV происходит на расстоянии от поверхности 2.6 μ m. При последующей термообработке в результате диффузии атомов Ag° возникают нанокластеры серебра — Ag°, что приводит к увеличению коэффициента поглощения. Так как исходный образец имеет низкую проводимость, то электронный луч заряжает поверхность. В результате этого в облученной зоне формируется поле, тормозящее и отклоняющее электроны (рис. 2, *a*, кривая *1*). Приведенная на рисунке зависимость напряженности электрического поля E(x) — качественная.

Это приводит к тому, что граничная часть облучаемой зоны подвергается воздействию большего количества электронов, имеющих



Рис. 2. a — распределение поля вблизи поверхности образца № 1 (I); расчетный профиль оптической толщины облученной зоны после термообработки (2). b — расчетная пространственная зависимость коэффициента отражения образца № 1 внутри и вблизи облученной зоны. Пунктиром показаны границы облученной зоны.

более высокую энергию. Поэтому результирующее распределение нанокластеров Ag_n^o по толщине образца вблизи поверхности принимает линзообразную форму и имеет в центральной части минимальную толщину и минимальную концентрацию. По краям облученной зоны толщина линзы и концентрация нанокластеров максимальны. Вне облученной зоны также формируется некоторое количество нанокластеров, что связано как с воздействием электронов, отклоненных поверхностным зарядом, так и с диффузией серебра при последующей термообработке. Оптическая толщина линзообразной структуры имеет вид, схематично показанный на рис. 2, а (кривая 2). Расчетная пространственная зависимость коэффициента отражения ($\lambda = 0.6 \, \mu m$) для такой линзообразной структуры представлена на рис. 2, b. Центральному максимуму отражения соответствует оптическая толщина, равная 200 nm, на границе облученной зоны она достигает 800 nm. При расчете предполагалось, что показатель преломления стекла равен 1.45, а эффективный показатель преломления облученной зоны с нанокластерами Ag^o, равен 1.449.

Электронно-лучевая обработка образца \mathbb{N}_2 сразу приводит к образованию в приповерхностном слое нанокластеров металлического Ag_n° в результате разложения наночастиц AgBr. Последующая термообработка вызывает коалесценцию нанокластеров, что повышает коэффициент поглощения. Наличие в исходном стекле полупроводниковых наночастиц AgBr и металлического серебра повышает его проводимость, поэтому в данном образце заряд поверхности электронным лучом влияет на пространственное распределение нанокластеров в меньшей степени, чем в образце \mathbb{N}_2 1.

Аналогичные процессы происходят при электронно-лучевой и термической обработке в образце № 3, содержащем нанокристаллы CuCl. Однако в данном образце формирование нанокластеров Cu_n° происходит более интенсивно. Более того, при стекании заряда из облученной зоны происходит поверхностный перенос атомов меди, сопровождающийся возникновением металлических дендритов, облегчающих сток заряда. Поэтому в данном образце линзоподобная структура практически отсутствует.

Таким образом, электронно-лучевая и термическая обработка ФЧГС, содержащих серебро и медь, позволяет создавать в приповерхностном и поверхностном слоях металлические нанокластеры. Заряд поверхности электронным лучом и сток заряда оказывают сильное влияние на пространственное распределение нанокластеров, что позволяет фор-

мировать линзоподобные и проводящие металлические поверхностные микроструктуры. Полученные результаты могут найти применение в интегральной оптике для создания матриц микролинз, плазмонных волноводов и планарных оптических переключателей, а также для создания химических и биосенсоров на основе плазмонных наноструктур.

Список литературы

- [1] Zayats A.V., Smolyaninov I.I., Maradudin A.A. // Phys. Rep. 2005. V. 408. P. 131– 314.
- [2] Kaganovskii Yu., Mogilko E., Ofir A., Lipovskii A.A., Rosenbluh M. Defect and Diffusion Forum. 2005. V. 237–240. P. 689–694.
- [3] Dotsenko A.V., Glebov L.B., Tsekhomsky V.A. Physics and Chemistry of Photochromic Glasses. CRC Press LLC, 1998. 190 p.
- [4] *Панышева Е.И., Туниманова И.В., Цехомский В.А.* // Физика и химия стекла. 1990. Т. 16. № 2. С. 239–244.
- [5] Никоноров Н.В., Панышева Е.И., Туниманова И.В., Чухарев А.В. // Физика и химия стекла. 2001. Т. 27. № 3. С. 365–376.
- [6] Панышева Е.И., Цехомский В.А. // Светотехника. 1984. № 11. С. 10–13.